

## บทที่ 4

### ผลการวิจัย

บทนี้เป็นข้อมูลจากการทดลองตามแนวทางการศึกษาในบทที่ 3 เริ่มจากการเตรียมพิล์มบางไทยเนี่ยม ได้อกไซด์โครงสร้างพลีกแบบอนาคต ประกอบด้วยผลของตัวแหน่งวางวัสดุรองรับ ผลของอัตราไอลแก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจน และศึกษาสมบัติไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า ได้ติกของพิล์ม โดยศึกษาผลของอัตราไอลแก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจนต่อสมบัติไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า ได้ติกของพิล์มบางไทยเนี่ยม ได้อกไซด์และผลของความหนาพิล์มต่อสมบัติไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า ได้ติก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

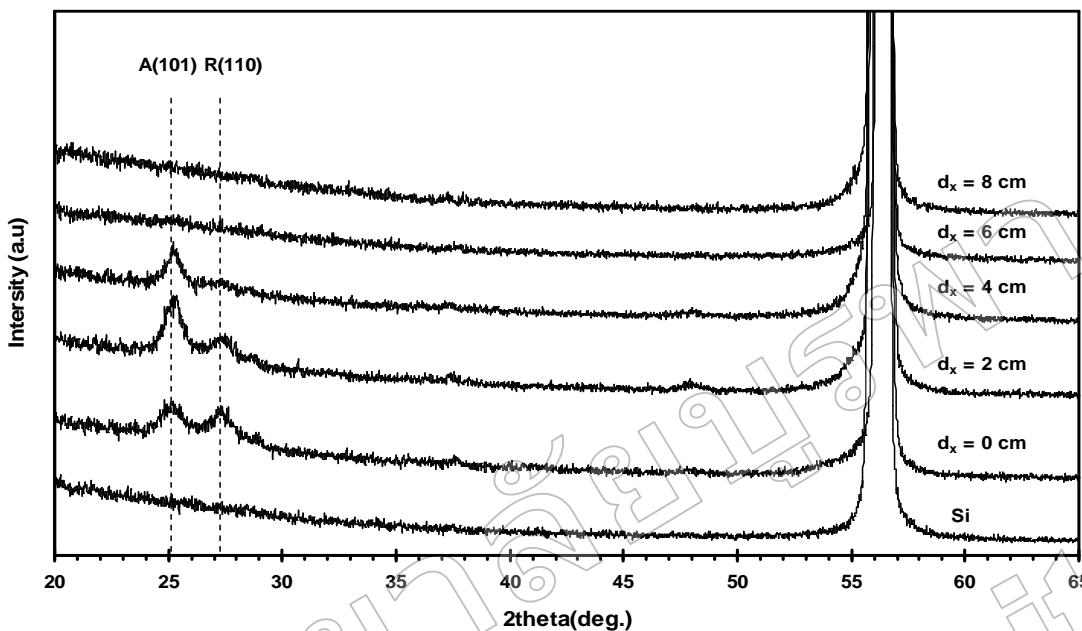
#### 1. การเตรียมพิล์มบางไทยเนี่ยม ได้อกไซด์โครงสร้างพลีกแบบอนาคต

ส่วนนี้เป็นการเสนอผลการศึกษารักษาลักษณะเฉพาะของพิล์มบางไทยเนี่ยม ได้อกไซด์เคลือบด้วยวิธี รีแอคติฟ ดีซี สปิตเตอริง ที่ตัวแหน่งวางวัสดุรองรับในแนววรรค์มีต่างกันและผลของอัตราไอลแก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจนต่างกัน รายละเอียดการศึกษารั้งนี้ ประกอบด้วย โครงสร้าง พลีก ความหนา และความหมายผิวของพิล์มบางไทยเนี่ยม ได้อกไซด์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

##### 1.1 ผลของตัวแหน่งวางวัสดุรองรับ

การเคลือบพิล์มบางไทยเนี่ยม ได้อกไซด์ในงานวิจัยนี้ ใช้วิธีรีแอคติฟ สปิตเตอริง ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อพิล์มที่เคลือบได้คือ อัตราไอลแก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจนและการเคลือบครั้งนี้ ใช้เท่ากับอัตราไอลแก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจนเท่ากับ 1:4 sccm (ธีระวิทย์ ดีลีศ, 2550) เคลือบพิล์มบนแผ่นชิลิกอน โดยปรค่าตัวแหน่งวางวัสดุรองรับในแนววรรค์มี ( $d_x$ ) มีผลดังต่อไปนี้

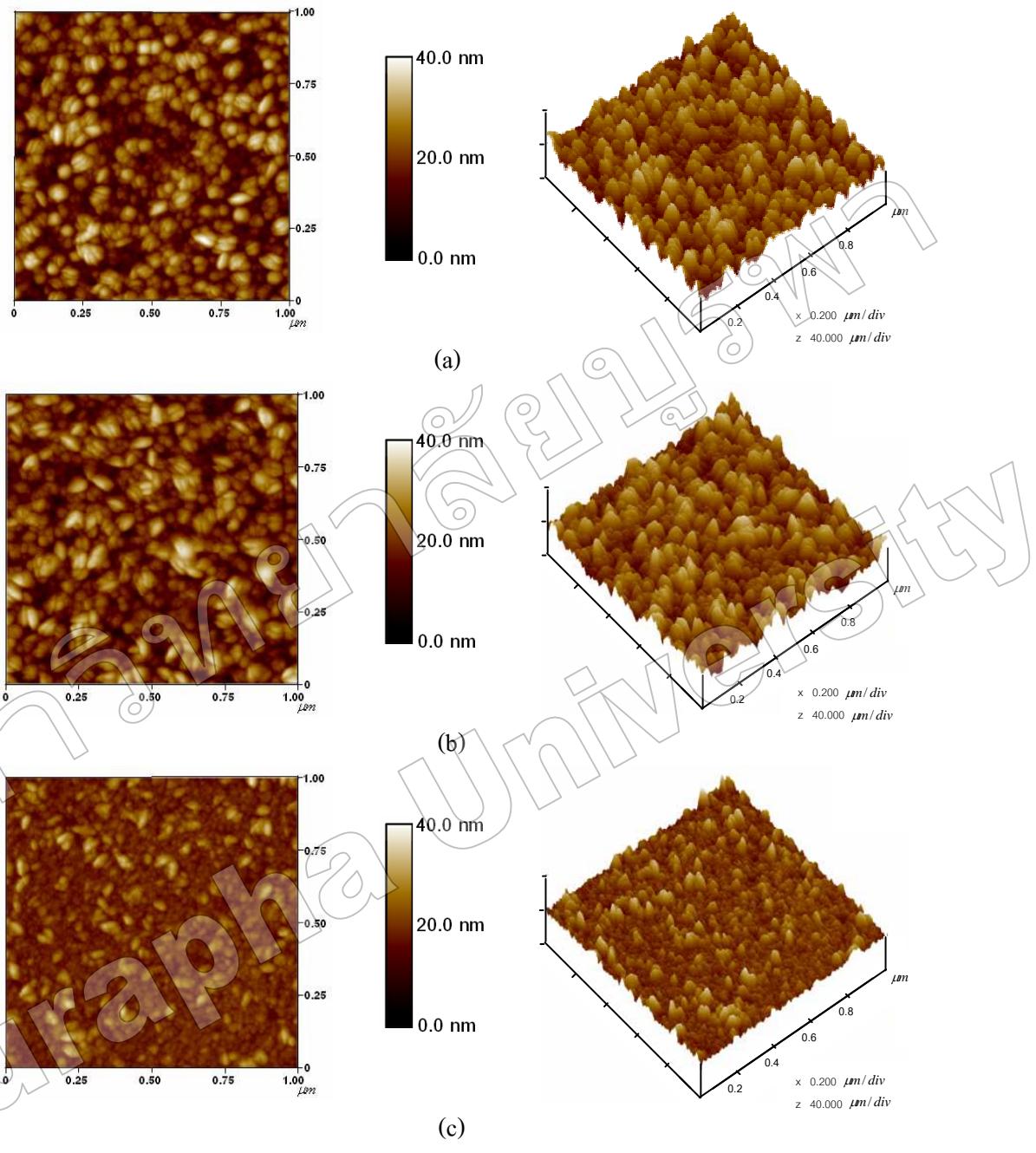
โครงสร้างพลีก ภาพที่ 4-1 แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์จากเทคนิค XRD ของพิล์มบางไทยเนี่ยม ได้อกไซด์เคลือบด้วยอัตราไอลแก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจน 1:4 sccm ที่ตัวแหน่งวางวัสดุรองรับในแนววรรค์มีต่างกัน พบว่าพิล์มบางเคลือบที่  $d_x$  เท่ากับ 0 cm และ 2 cm มีรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุน 20 เท่ากับ 25.3 องศา และ 27.4 องศา เมื่อเปรียบเทียบกับกราฟรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของสารประกอบ ไทยเนี่ยม ได้อกไซด์ตามมาตรฐาน JCPDS



ภาพที่ 4-1 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไททาเนียม ไดออกไซด์ที่เคลือบໄດ້  
ເມື່ອແປຣຄ່າ  $d_x$

พบว่าตรงกับไททาเนียม ไดออกไซด์ โครงสร้างผลึกแบบอนาเทสระนาบ (101) กับรู๊ไทล์ระนาบ (110) และเมื่อ  $d_x$  เท่ากับ 4 cm พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุม  $2\theta$  เท่ากับ 25.3 องศา ตรงกับกราฟรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของสารประกอบไททาเนียม ไดออกไซด์ตามมาตรฐาน JCPDS โครงสร้างผลึกแบบอนาเทสระนาบ (101) ขณะที่  $d_x$  เท่ากับ 6 cm และ 8 cm ไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของกับไททาเนียม ไดออกไซด์

ลักษณะพื้นผิวและความหนา ฟิล์มที่เคลือบໄດ້ໃນขั้นตอนนี้ມีความหนาอยู่ในช่วง 82 nm - 156 nm และความหยาบผิวอยู่ในช่วง 1 nm - 5 nm รายละเอียดแสดงในตาราง 4-1 จากการศึกษาลักษณะพื้นผิวของฟิล์มด้วยเทคนิค AFM พบว่าฟิล์มเคลือบที่ตำแหน่ง  $d_x$  เท่ากับ 0 cm และ 2 cm พื้นผิวมีลักษณะขรุขระ เกรน มีขนาดเล็กใหญ่ปะปนกัน เป็นแท่งสูงปลายมน กระจายอยู่ทั่วพื้นผิวของฟิล์ม (ภาพที่ 4-4 (a) และภาพที่ 4-4 (b)) สำหรับฟิล์มบางเคลือบที่ตำแหน่ง  $d_x$  เท่ากับ 4 cm พื้นผิวฟิล์มมีลักษณะขรุขระ เกรน มีขนาดเล็กແղມกระจายอยู่ทั่วพื้นผิวของฟิล์ม (ภาพที่ 4-5 (c)) ส่วนฟิล์มเคลือบที่ตำแหน่ง  $d_x$  เท่ากับ 6 cm และ 8 cm พื้นผิวมีลักษณะขรุขระลดลง เกรน มีขนาดเล็กมนกระจายอยู่ปะปนผิวฟิล์ม (ภาพที่ 4-4 (d) และภาพที่ 4-4 (e))

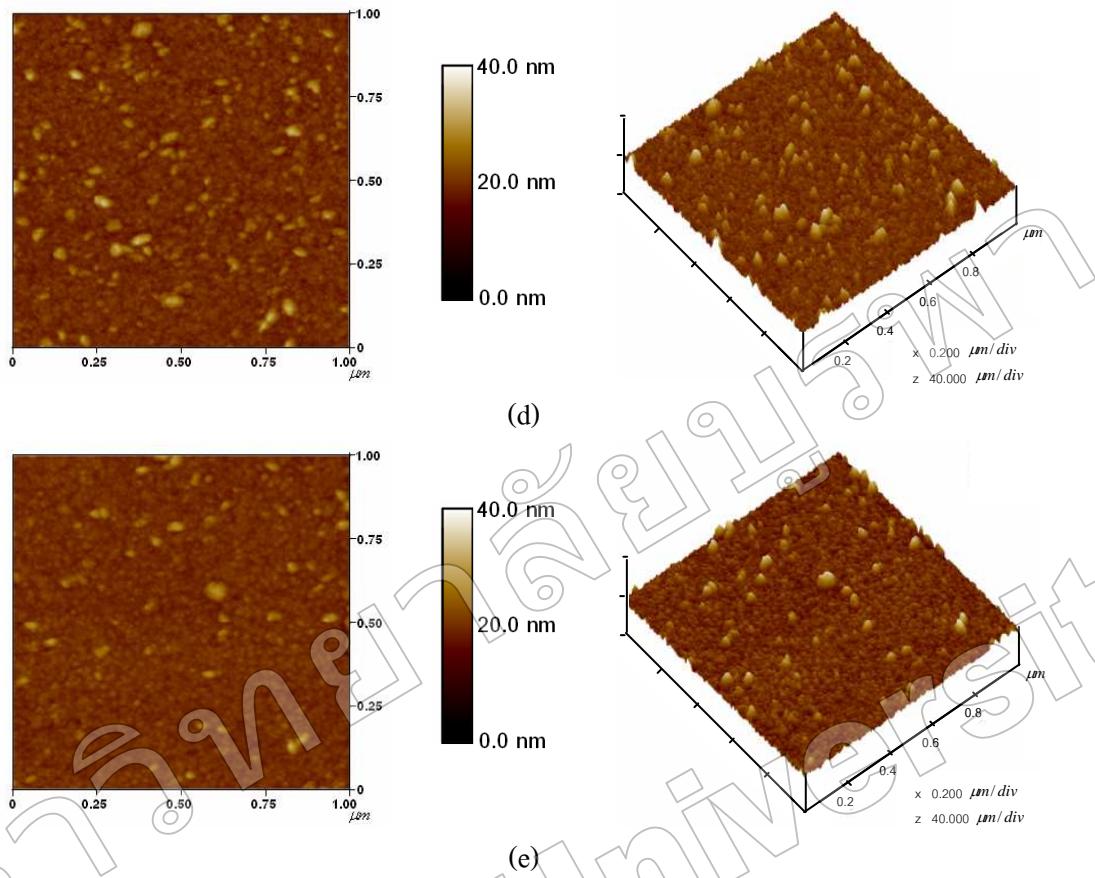


ภาพที่ 4-2 ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไททาเนียม ไดออกไซด์ที่เคลือบได เมื่อปรับค่า  $d_x$

(a)  $d_x = 0 \text{ cm}$

(b)  $d_x = 2 \text{ cm}$

(c)  $d_x = 4 \text{ cm}$



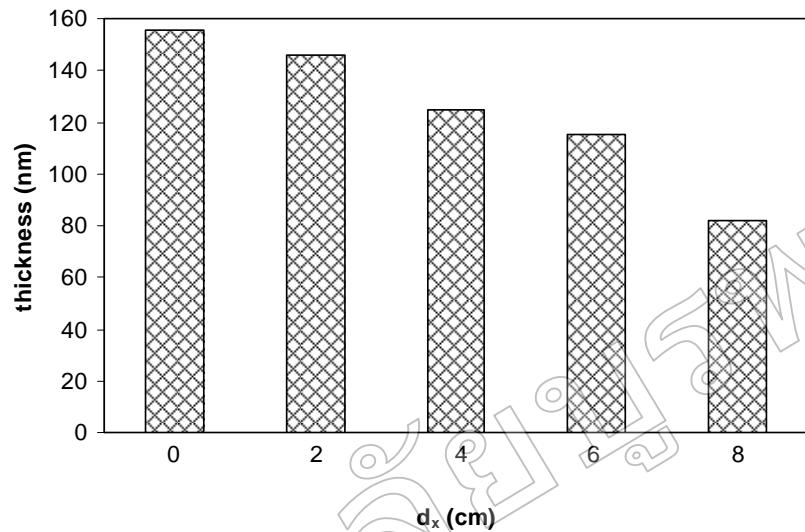
ภาพที่ 4-2 ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบได เมื่อเปลี่ยนค่า  $d_x$  (ต่อ)

(d)  $d_x = 6 \text{ cm}$

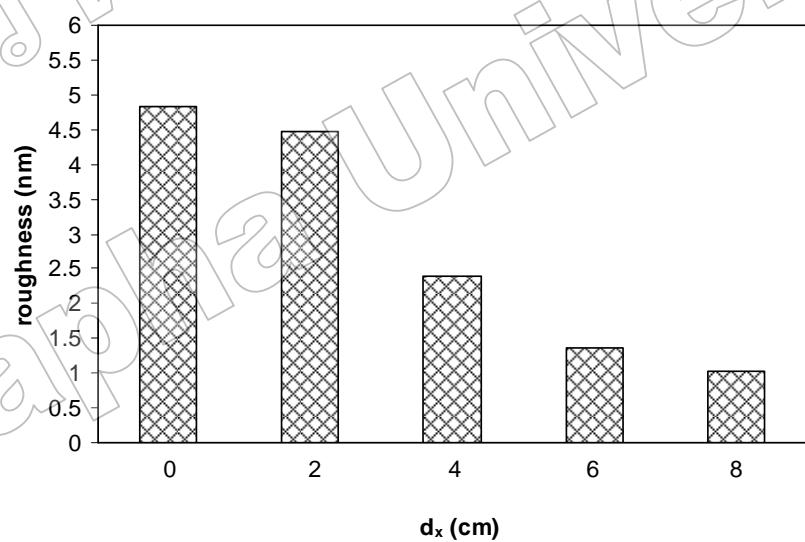
(e)  $d_x = 8 \text{ cm}$

ตารางที่ 4-1 ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบได เมื่อเปลี่ยนค่า  $d_x$

ตำแหน่ง $d_x$ (cm)	ความหนา (nm)	ความหยาบผิว (nm)
0	156	4.8
2	146	4.5
4	125	2.4
6	115	1.4
8	82	1.0



ภาพที่ 4-3 เปรียบเทียบความหนาของฟิล์มนางไททาเนียม ไดออกไซด์ที่เคลือบได เมื่อเปลี่ยนค่า  $d_x$

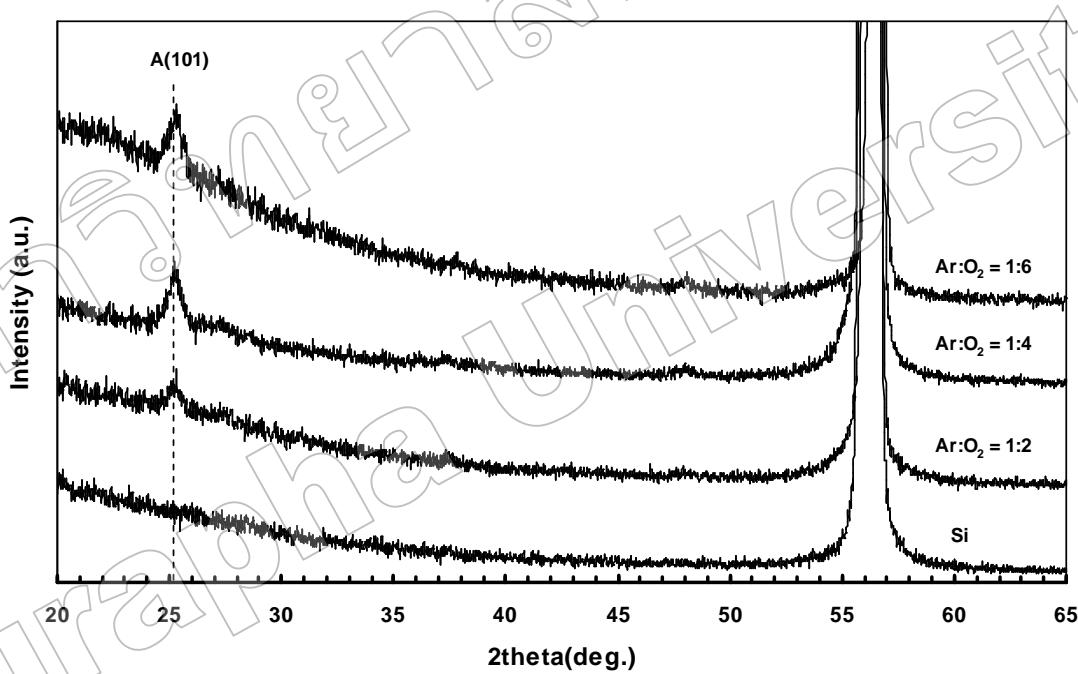


ภาพที่ 4-4 เปรียบเทียบความหยาบผิวของฟิล์มนางไททาเนียม ไดออกไซด์ที่เคลือบได เมื่อเปลี่ยนค่า  $d_x$

### 1.2 ผลของอัตราไหหลแก๊สต่อลักษณะเฉพาะของฟิล์ม

ขั้นตอนนี้เป็นผลของการเคลือบฟิล์มบางๆ ทางเนียมโดยออกไซด์บนแผ่นซิลิโคนที่ตำแหน่ง  $d_x = 4 \text{ cm}$  โดยแปรค่าอัตราไหหลแก๊สสาร์กอนต่อออกซิเจน ซึ่งมีผลดังต่อไปนี้

โครงสร้างผลึก จากภาพที่ 4-5 แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์จากเทคนิค XRD ของฟิล์มบางๆ ทางเนียมโดยออกไซด์เคลือบที่  $d_x = 4 \text{ cm}$  โดยใช้อัตราไหหลแก๊สสาร์กอนต่อออกซิเจนเท่ากับ 1:2 sccm 1:4 sccm และ 1:6 sccm จากการศึกษาพบว่าฟิล์มที่เคลือบได้มีรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุ่ง 2θ เท่ากับ 25.3 องศา สำหรับทุกค่าอัตราไหหลแก๊ส เมื่อเปรียบเทียบกับกราฟรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของสารประกอบทางเนียมโดยออกไซด์ตามมาตรฐาน JCPDS พบว่าตรงกับทางเนียมโดยออกไซด์โครงสร้างผลึกแบบอนุพัทธะนาน (101)

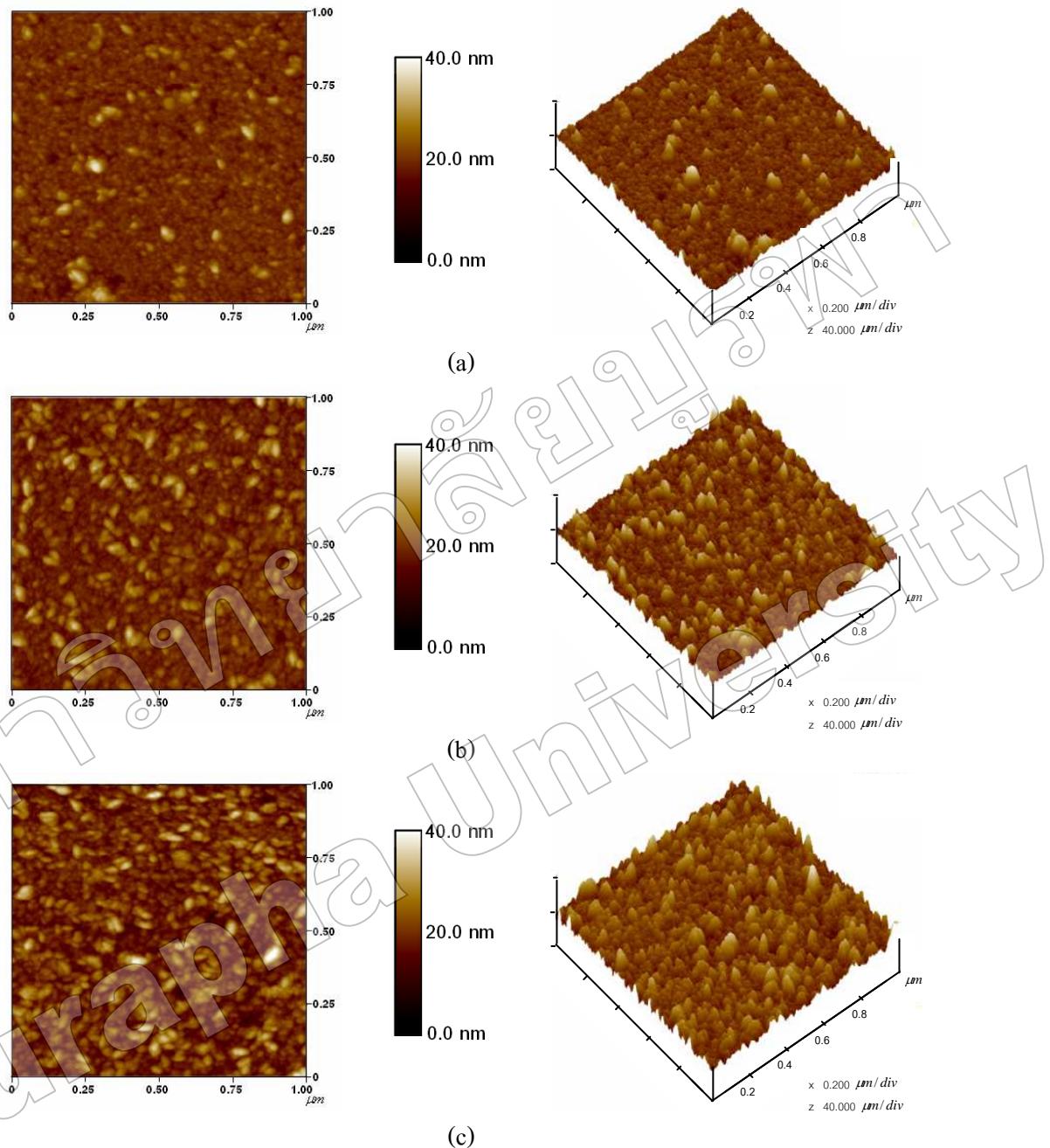


ภาพที่ 4-5 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางๆ ทางเนียมโดยออกไซด์เคลือบที่  $d_x = 4 \text{ cm}$  เมื่อแปรค่าอัตราไหหลแก๊สสาร์กอนต่อออกซิเจน

ลักษณะพื้นผิวและความหนา ฟิล์มบางไทยเนียนได้ออกไซค์ที่เคลือบได้ในขั้นตอนนี้ มีความหนาอยู่ในช่วง 117 nm - 137 nm และมีความหนาแน่นพิวอยู่ในช่วง 1.6 nm- 3.3 nm ซึ่งค่าความหนาและความหนาแน่นพิวแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4-2 จากการศึกษาลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไทยเนียนได้ออกไซค์ด้วยเทคนิค AFM พบว่าฟิล์มที่เคลือบด้วยอัตราไหหลแก๊สสารกอนต่อออกซิเจนเท่ากับ 1:2 sccm พื้นผิวมีเกรนเม็ดขนาดเล็กใหญ่ปะปันกันและปลายมีลักษณะมน กระจายอยู่บางบริเวณบนพื้นฟิล์ม (ภาพที่ 4-6 (a)) สำหรับฟิล์มบางที่เคลือบด้วยอัตราไหหลแก๊สสารกอนต่อออกซิเจนเท่ากับ 1:4 sccm พื้นผิวฟิล์มนี้ลักษณะขรุขระ เกรนเม็ดขนาดเล็กแหลมกระชาวยอยู่ทั่วผิวฟิล์ม (ภาพที่ 4-6 (b)) ส่วนฟิล์มที่เคลือบด้วยอัตราไหหลแก๊สสารกอนต่อออกซิเจนเท่ากับ 1:6 sccm พื้นผิวมีลักษณะขรุขระ เกรนเม็ดขนาดแหลมปานมนกระชาวยอยู่ทั่วบริเวณพื้นฟิล์ม(ภาพที่ 4-6 (d)) และภาพที่ 4-6 (c)) สำหรับค่าความหนาและความหนาแน่นพิวของฟิล์มแสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-2 ความหนาและความหนาแน่นพิวของฟิล์มบางไทยเนียนได้ออกไซค์ที่เคลือบได้มีประค่าอัตราไหหลแก๊สสารกอนต่อออกซิเจน

อัตราไหหลแก๊สสารกอนต่อออกซิเจน (sccm)	ความหนา (nm)	ความหนาแน่นพิว (nm)
1:2	117	1.6
1:4	125	2.4
1:6	137	3.3



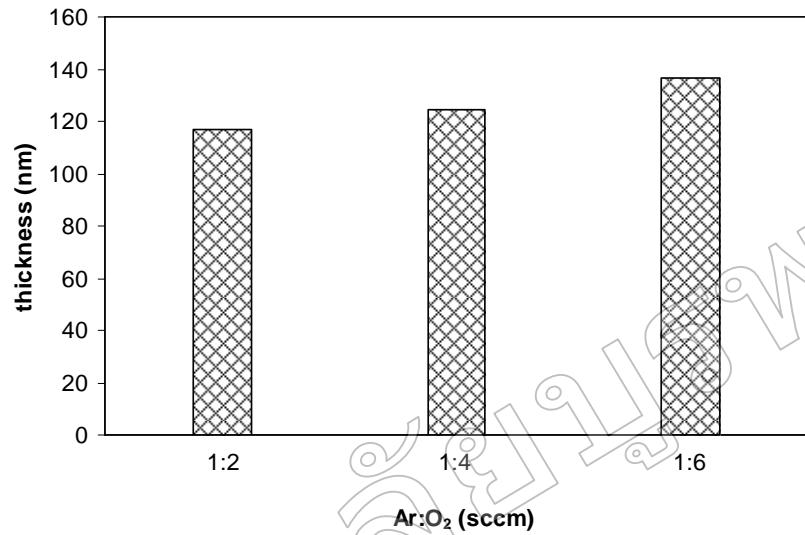
ภาพที่ 4-6 ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไฟฟานียมไดออกไซด์

เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราไหლแก๊สสาร์กอนต่อออกซิเจน

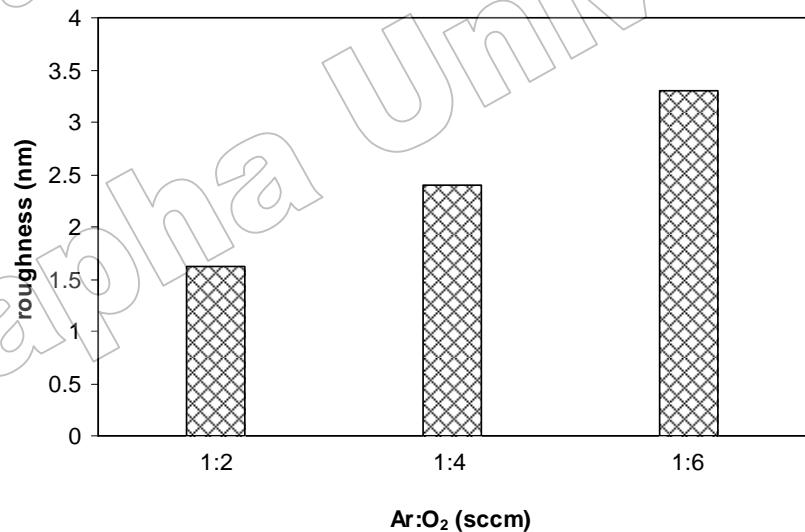
(a) อัตราไหლแก๊สสาร์กอนต่อออกซิเจนเท่ากับ 1:2 sccm

(b) อัตราไหლแก๊สสาร์กอนต่อออกซิเจนเท่ากับ 1:4 sccm

(c) อัตราไหლแก๊สสาร์กอนต่อออกซิเจนเท่ากับ 1:6 sccm



ภาพที่ 4-7 เปรียบเทียบความหนาของฟิล์มบางไททาเนียม ไดออกไซด์เคลือบที่  $d_x = 4\text{ cm}$   
เมื่อแปรค่าอัตราไหლแก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจน



ภาพที่ 4-8 เปรียบเทียบความหยาบผิวของฟิล์มบางไททาเนียม ไดออกไซด์เคลือบที่  $d_x = 4\text{ cm}$   
เมื่อแปรค่าอัตราไหลแก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจน

## 2. สมบัติไฟฟ้าและไฟฟ้าสถิตของฟิล์มน้ำยาไทยเนียมไดออกไซด์

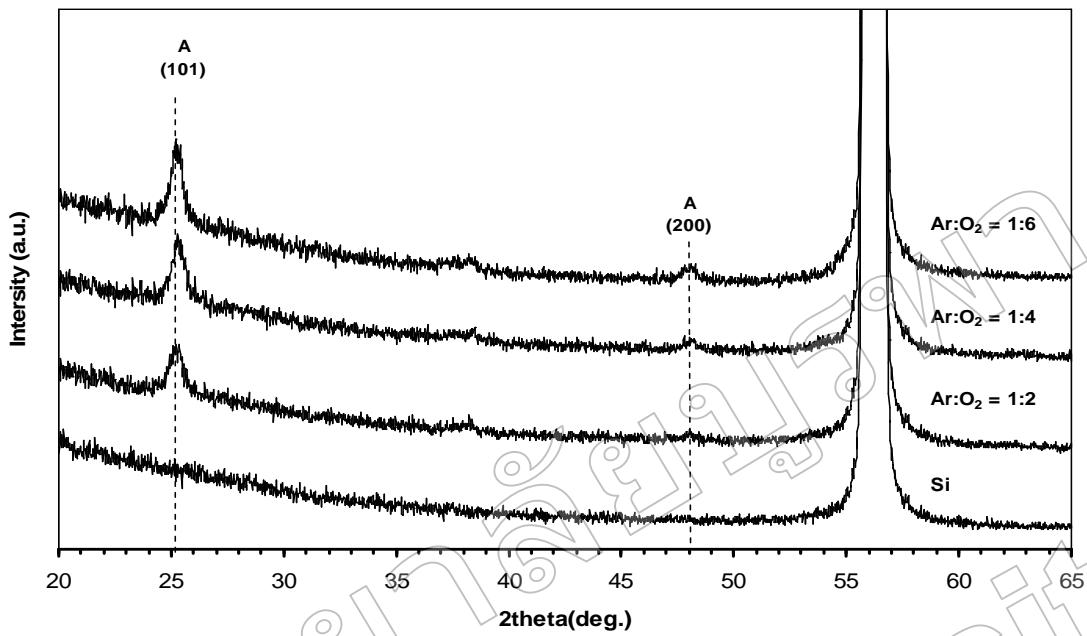
### 2.1 ผลของอัตราไอลแก๊สต่อลักษณะเฉพาะและสมบัติไฟฟ้าและไฟฟ้าสถิตของฟิล์ม

ขั้นตอนนี้เป็นผลการศึกษาสมบัติไฟฟ้าและไฟฟ้าสถิตของฟิล์มน้ำยาไทยเนียม

ไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นกระจกและแผ่นซิลิโคน ที่ตำแหน่ง  $d_x = 4 \text{ cm}$  โดยปรับค่าอัตราไอลแก๊สสาร์กอนต่อออกซิเจน ฟิล์มที่เคลือบได้มีลักษณะเฉพาะและสมบัติไฟฟ้าและไฟฟ้าสถิตของฟิล์มต่อไปนี้

ลักษณะเฉพาะของฟิล์มน้ำยาไทยเนียมไดออกไซด์ โครงสร้างผลึก ภาพที่ 4-9 แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์จากเทคนิค XRD ของฟิล์มน้ำยาไทยเนียมไดออกไซด์ที่ตำแหน่ง  $d_x = 4 \text{ cm}$  โดยปรับค่าอัตราไอลแก๊สสาร์กอนต่อออกซิเจนเท่ากับ 1:2 sccm 1:4 sccm และ 1:6 sccm ผลการศึกษาพบว่าฟิล์มที่เคลือบได้มีรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุม 20 เท่ากับ 25.3 องศา สำหรับทุกค่าอัตราไอลแก๊ส เมื่อเปรียบเทียบกับกราฟรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของสารประกอบน้ำยาไทยเนียมไดออกไซด์ตามมาตรฐาน JCPDS ตรงกับน้ำยาไทยเนียมไดออกไซด์โครงสร้างผลึกแบบอนาเทสระนาบ (101)

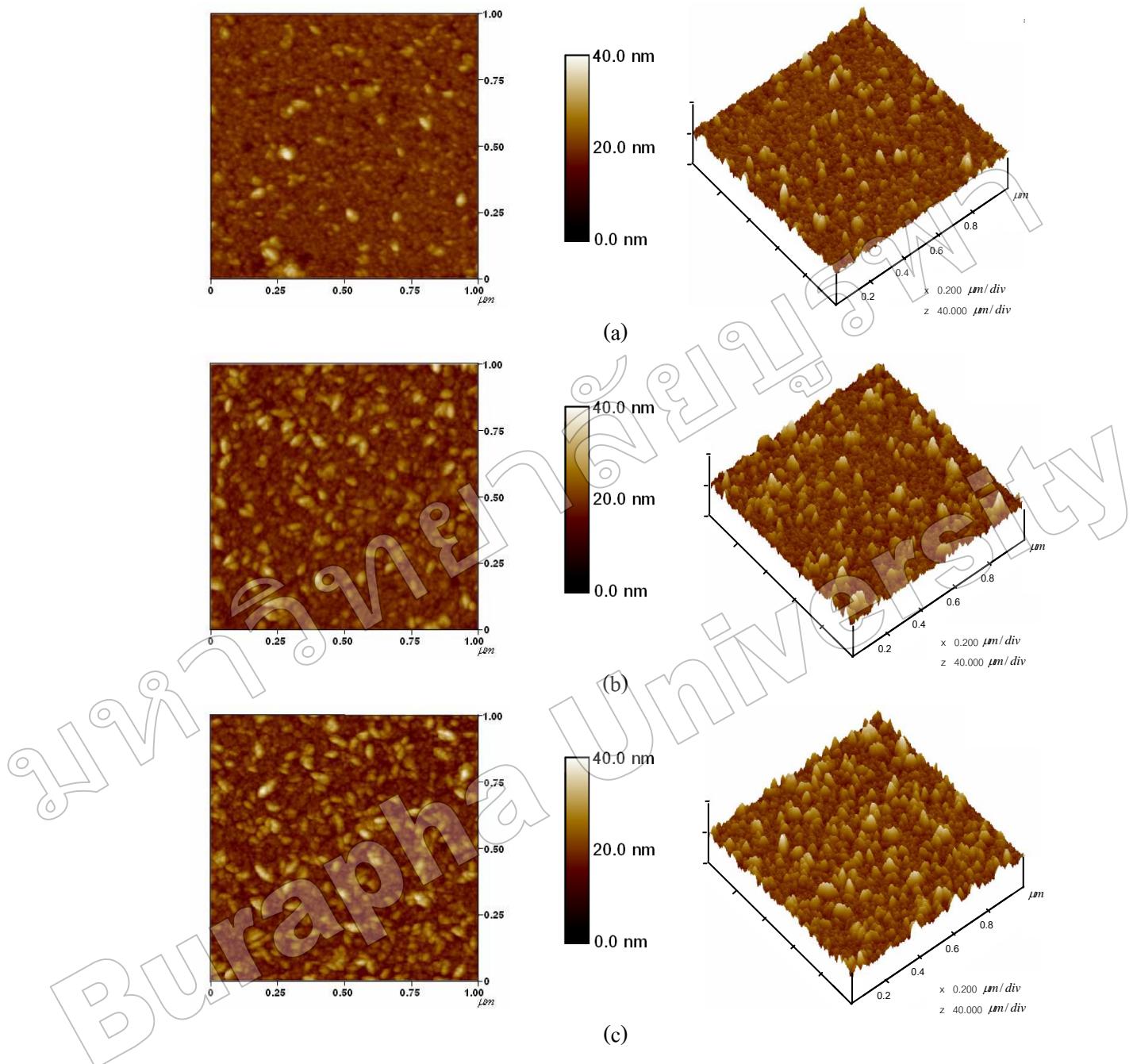
ลักษณะพื้นผิวและความหนา ผลการศึกษาการเคลือบฟิล์มน้ำยาไทยเนียมไดออกไซด์เคลือบที่ตำแหน่ง  $d_x = 4 \text{ cm}$  โดยปรับค่าอัตราไอลแก๊สสาร์กอนต่อออกซิเจน ฟิล์มที่เคลือบได้ในขั้นตอนนี้มีความหนาอยู่ในช่วง 119 nm - 140 nm และมีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 2.6 nm - 3.6 nm ซึ่งค่าความหนาและความหนาแน่นแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4-3 จากการตรวจสอบด้วยเทคนิค AFM พบว่าสำหรับทุกค่าอัตราไอลแก๊สสาร์กอนต่อออกซิเจน ฟิล์มที่ได้มีลักษณะพื้นผิวคล้ายกันมีขนาดเกรนใกล้เคียงกัน เกรนมีปลายน้ำเงินกระจายอยู่ทั่วผิวฟิล์ม (ภาพที่ 4-10 - ภาพที่ 4-10 (c))



ภาพที่ 4-9 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบไดเมื่อปรับค่าอัตราไหლแก๊สสาร์กอนต่อออกซิเจน

ตารางที่ 4-3 ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์เคลือบบนกระดาษเมื่อปรับค่าอัตราไหლแก๊สสาร์กอนต่อออกซิเจน

อัตราไหลแก๊สสาร์กอนต่อออกซิเจน (sccm)	ความหนา (nm)	ความหยาบผิว (nm)
1:2	140	2.6
1:4	123	3.4
1:6	119	3.6



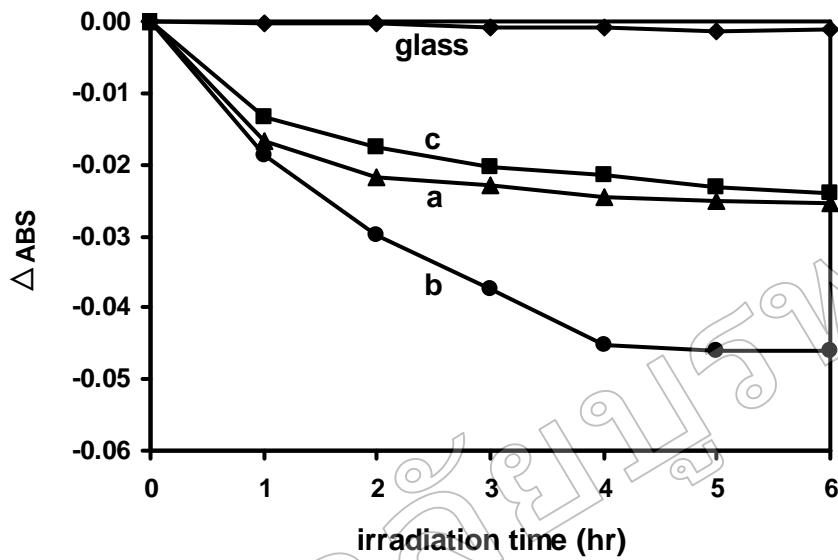
ภาพที่ 4-10 ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มเคลือบเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราไหหลแก๊สสาร์กอนต่อออกซิเจน

(a) อัตราไหหลแก๊สสาร์กอนต่อออกซิเจนเท่ากับ 1:2 sccm

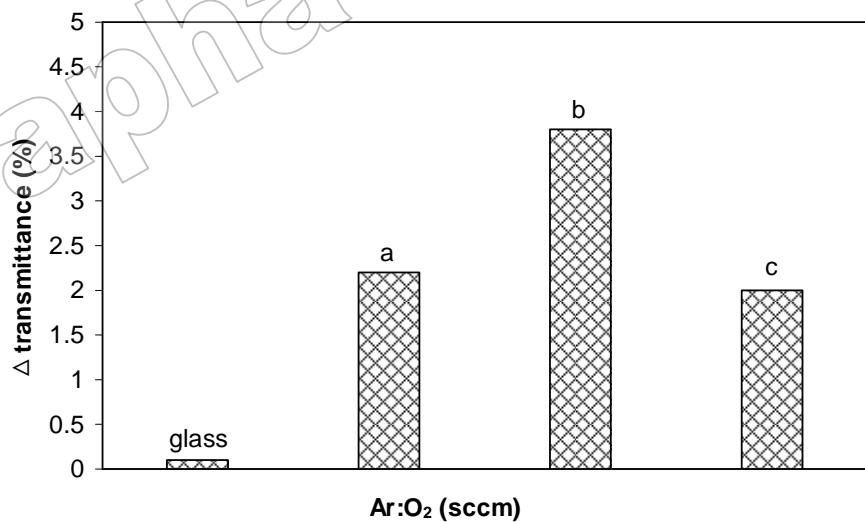
(b) อัตราไหหลแก๊สสาร์กอนต่อออกซิเจนเท่ากับ 1:4 sccm

(c) อัตราไหหลแก๊สสาร์กอนต่อออกซิเจนเท่ากับ 1:6 sccm

สมบัติโฟโตคตะไลติกของฟิล์มไทยนานีym โดยอกไชด์ เมื่อนำฟิล์มบางไทยนานีym โดยอกไชด์ที่เคลือบได้มาทดสอบสมบัติโฟโตคตะไลติก โดยพิจารณาจากค่าแอบซอร์เบนซ์ของสารเมทิลีนบลู ซึ่งแสดงรายละเอียดค่าแอบซอร์เบนของสารเมทิลีนบลูที่ nationality แสงยูวีทุก ๆ ชั่วโมง ไว้ในตาราง ก-1 และภาพที่ 4-11 แสดงค่าแอบซอร์เบนซ์ของสารเมทิลีนบลูเมื่อ nationality แสงยูวีที่เวลาต่าง ๆ กัน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าแอบซอร์เบนซ์ของสารเมทิลีนบลูที่ได้จากการทดสอบสมบัติโฟโตคตะไลติกของฟิล์ม โดยใช้ค่าแอบซอร์เบนซ์บนกระจาดเปล่าเคลือบฟิล์มเป็นตัวเปรียบเทียบ ซึ่งพบว่าฟิล์มที่เคลือบได้โดยประค่าอัตราไหลดแก๊สสาร์กอนต่อออกซิเจนต่าง ๆ กันทุกค่า เกิดสมบัติโฟโตคตะไลติกเมื่อ nationality แสงยูวี (UV) เป็นเวลา 6 ชั่วโมง ซึ่งค่าแอบซอร์เบนซ์ของสารเมทิลีนบลูบนฟิล์มที่เคลือบด้วยอัตราไหลดแก๊สสาร์กอนต่อออกซิเจนเท่ากับ 1:2 sccm มีค่าลดลง -0.025 ขณะที่ค่าแอบซอร์เบนซ์ของสารเมทิลีนบลูบนฟิล์มที่เคลือบด้วยอัตราไหลดแก๊สาร์กอนต่อออกซิเจนเท่ากับ 1:4 sccm มีค่าลดลง -0.046 ขณะที่ค่าแอบซอร์เบนซ์ของสารเมทิลีนบลูบนฟิล์มที่เคลือบด้วยอัตราไหลดแก๊สาร์กอนต่อออกซิเจนเท่ากับ 1:6 sccm มีค่าลดลง -0.024 และภาพที่ 4-12 แสดงการเปรียบเทียบค่าผลต่างของการส่งผ่านแสงก่อน nationality แสงยูวี ( $\%T_0$ ) และค่าการส่งผ่านแสงหลัง nationality แสงยูวี ( $\%T_6$ ) เป็นเวลา 6 ชั่วโมง โดย  $\Delta T\% = \%T_6 - \%T_0$  พบร่วาหากเกิดการย่อยสลายสารเมทิลีนบลูในกระบวนการโฟโตคตะไลติกแล้ว สารเมทิลีนบลูที่ย้อมบนพิวของฟิล์มจะคงลงและมีค่าการส่งผ่านแสงเพิ่มขึ้นและยังพบว่าค่าแอบซอร์เบนซ์ของสารเมทิลีนบลูบนฟิล์มที่เคลือบด้วยอัตราไหลดแก๊สสาร์กอนต่อออกซิเจนเท่ากับ 1:4 sccm มีค่าลดลงมากที่สุดและมีค่าผลต่างการส่งผ่านแสงหลังการ nationality แสงยูวีสูงที่สุดด้วย รายละเอียดแสดงในตาราง ก-3



ภาพที่ 4-11 ค่าแอนด์รัมเม้นซ์ของสารเมทิลีนบลูจากการทดสอบสมบัติไฟโตคติกของฟิล์มที่เคลือบเมื่อแบร์ค่าอัตราไหเดแก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจน  
 (a) อัตราไหเดแก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจนเท่ากับ 1:2 sccm  
 (b) อัตราไหเดแก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจนเท่ากับ 1:4 sccm  
 (c) อัตราไหเดแก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจนเท่ากับ 1:6 sccm

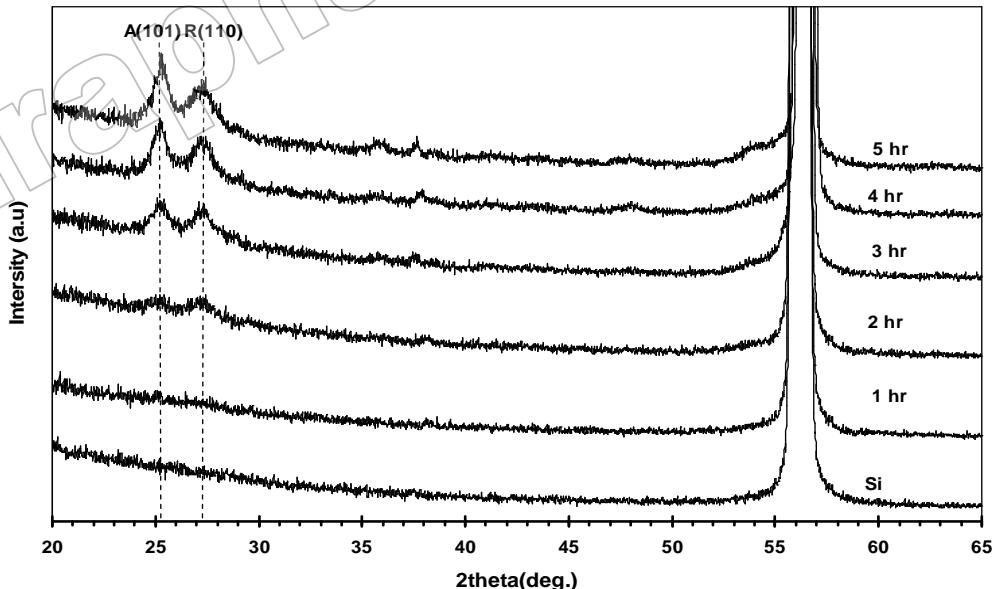


ภาพที่ 4-12 การส่งผ่านแสงเมื่อจายแสงยูวี 6 ชั่วโมง จากการทดสอบสมบัติไฟโตคติกของฟิล์มที่เคลือบด้วยอัตราไหเดแก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจนต่างกัน

## 2.2 ผลของความหนาฟิล์มต่อสมบัติไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า

ขั้นตอนนี้เป็นผลการศึกษาสมบัติไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบลงบนกระดาษแผ่นซิลิกอนโดยแปรค่าความหนาของฟิล์ม เมื่อใช้อัตราไฟลแก๊สเท่ากับ  $1:4 \text{ sccm}$  ที่ตำแหน่ง  $d_x = 4 \text{ cm}$  ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ฟิล์มนี้โครงสร้างผลึกแบบอนาเทสและมีสมบัติไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าดีที่สุด การเตรียมฟิล์มชุดนี้ได้มีการเปลี่ยนอุปกรณ์การแปรค่าความต่างศักย์ที่จ่ายให้กับหัวคาโทด หลังการเปลี่ยนอุปกรณ์พบว่าความต่างศักย์ที่จ่ายให้หัวคาโทดจะเพิ่มขึ้นเป็น  $445 \text{ V}$  ที่กระแสคาโทดคงที่  $500 \text{ mA}$  และตัวแปรเงื่อนไขอื่นยังคงควบคุมให้คงที่ รายละเอียด มีดังต่อไปนี้

ลักษณะเฉพาะของฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ โครงสร้างผลึก จากภาพที่ 4-13 แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์จากเทคนิค XRD ของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์เคลือบที่ตำแหน่ง  $d_x = 4 \text{ cm}$  พบร่วมเมื่อเคลือบฟิล์มเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จะไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของไททาเนียมไดออกไซด์ แต่เมื่อเคลือบฟิล์มเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง และ 5 ชั่วโมง พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุ่ง 20 เท่ากับ 25.3 องศา และ 27.4 องศา เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของสารประกอบไททาเนียมไดออกไซด์ตามมาตรฐาน JCPDS พบว่าตรงกับไททาเนียมไดออกไซด์โครงสร้างผลึกแบบอนาเทสระนาบ (101) และรูไกร์ระนาบ (110) นอกจากนี้ยังพบว่าความเข้มของการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์จะเพิ่มขึ้นเมื่อความหนาของฟิล์มเพิ่มขึ้นตามลำดับ

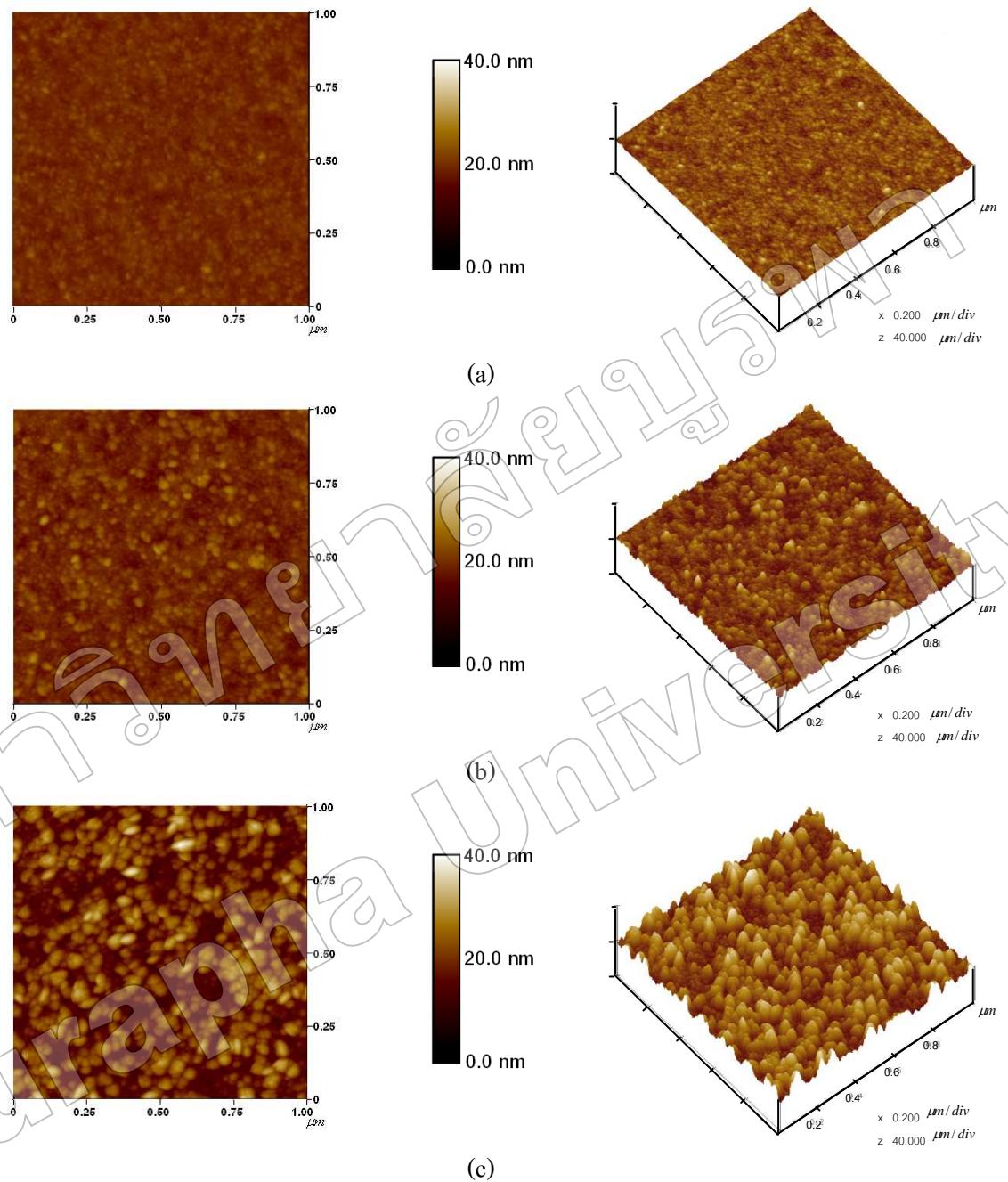


ภาพที่ 4-13 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ

ลักษณะพื้นผิวและความหนา ผลการศึกษาการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์เคลือบที่ตำแหน่ง  $d_x = 4 \text{ cm}$  อัตราไอลแก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจนเท่ากับ 1:4 sccm และประค่าเวลาการเคลือบ ฟิล์มที่เคลือบได้ในขั้นตอนนี้มีความหนาอยู่ในช่วง 51 nm - 220 nm และมีความหนาพิวอยู่ในช่วง 0.8 nm- 7.0 nm ซึ่งค่าความหนาและความหนาพิวแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4-4 จากการตรวจสอบด้วยเทคนิค AFM พบว่าเมื่อเคลือบฟิล์มเป็นเวลานานขึ้นฟิล์มที่ได้จะมีความหนาเพิ่มขึ้นและยังพบว่าเมื่อเคลือบฟิล์มเป็นเวลานานขึ้นจะพบลักษณะกรนของฟิล์ม โดยขั้นและมีลักษณะปลายมนขนาดเล็กใหญ่ปะปนกัน นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อเคลือบฟิล์มเป็นเวลานานขึ้นฟิล์มที่ได้จะมีความหนาพิวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มที่เคลือบได้ในขั้นตอนนี้แสดงในภาพที่ 4-14 (a) - ภาพที่ 4-14 (e)

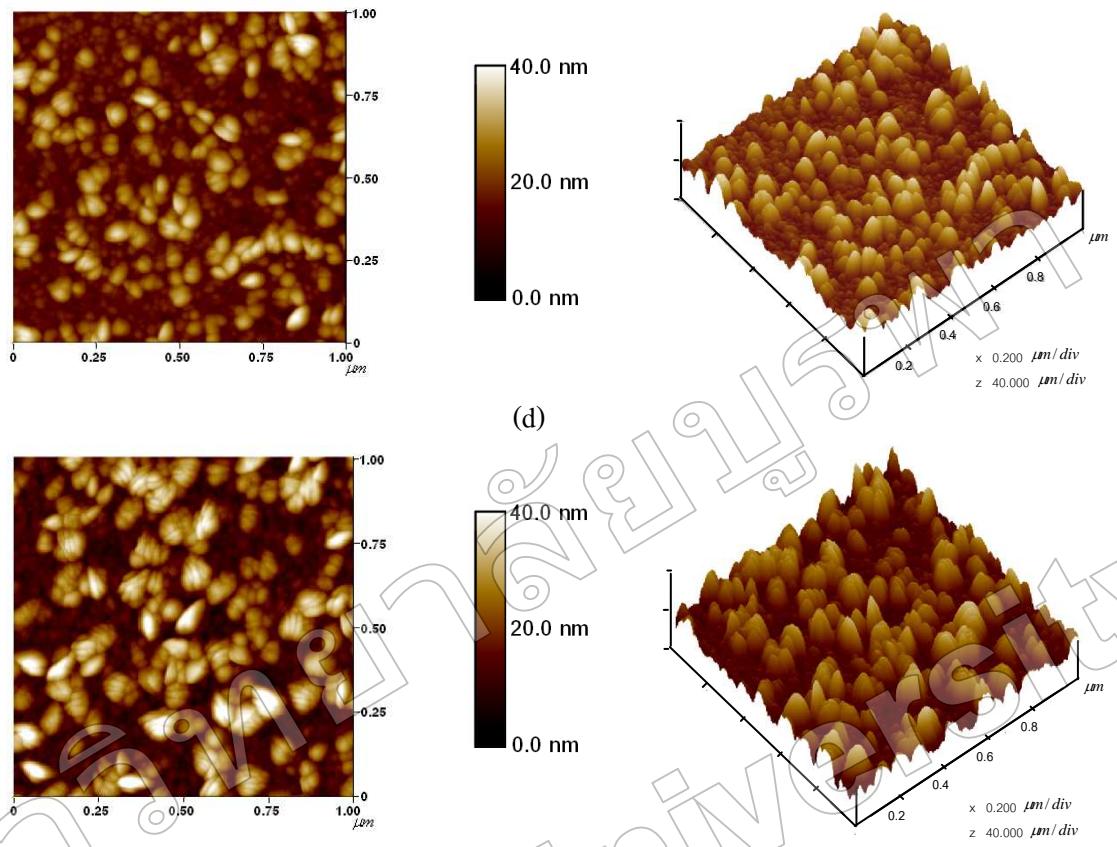
ตารางที่ 4-4 ความหนาและความหนาพิวของฟิล์มบางไททาเนียมโดยออกไซด์ เมื่อใช้วิธีการเคลือบฟิล์มต่าง ๆ กัน

เวลาการเคลือบ (ชั่วโมง)	ความหนา (nm)	ความหนาพิว (nm)
1	51	0.8
2	73	1.4
3	133	3.7
4	184	4.6
5	220	7.0



ภาพที่ 4-14 ลักษณะพื้นผิวและความหนาของฟิล์มที่เคลือบด้วยเวลาการเคลือบต่าง ๆ กัน

- (a) เวลาการเคลือบ 1 ชั่วโมง ความหนาเท่ากับ 51 nm
- (b) เวลาการเคลือบ 2 ชั่วโมง ความหนาเท่ากับ 73 nm
- (c) เวลาการเคลือบ 3 ชั่วโมง ความหนาเท่ากับ 133 nm

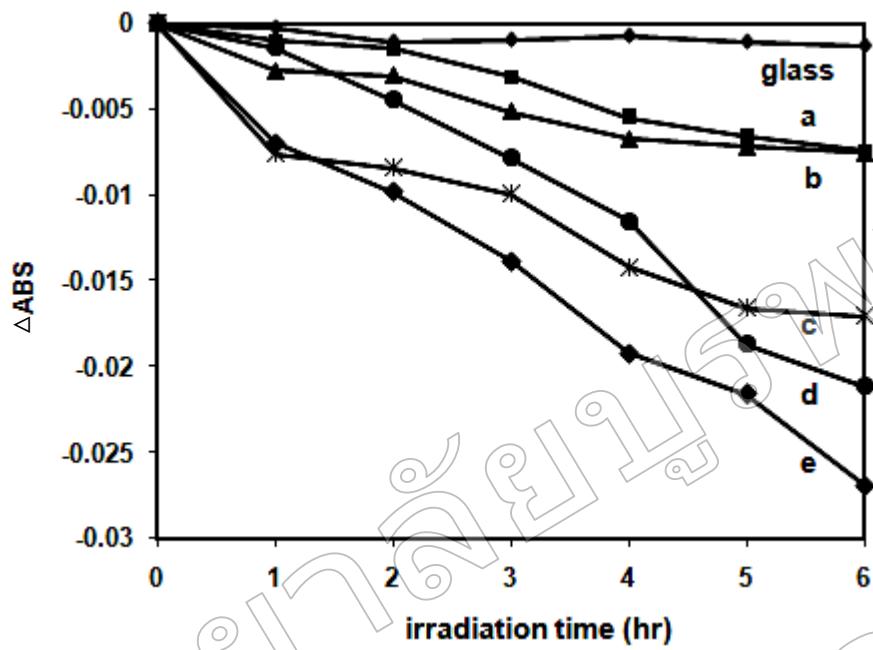


ภาพที่ 4-14 ลักษณะพื้นผิวและความหนาของฟิล์มที่เคลือบด้วยเวลาการเคลือบต่าง ๆ กัน (ต่อ)

(d) เวลาการเคลือบ 4 ชั่วโมง ความหนาเท่ากับ 184 nm

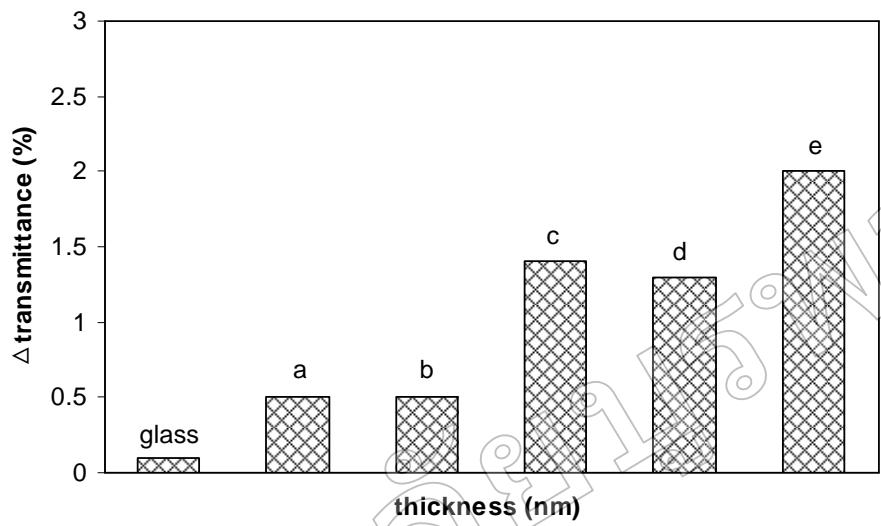
(e) เวลาการเคลือบ 5 ชั่วโมง ความหนาเท่ากับ 220 nm

สมบัติโฟโตคตะไลติกของฟิล์มไทยนานียมไดออกไซด์ เมื่อนำฟิล์มบางไทยนานียมไดออกไซด์ที่เคลือบความหนาต่างกันไปทดสอบสมบัติ โฟโตคตะไลติกโดยพิจารณาจากค่าแอบซอร์บแนนซ์ของสารเมทิลีนบลูผลการทดสอบที่ได้แสดงรายละเอียดในตาราง ก-2 และจากภาพที่ 4-15 ได้แสดงการเปรียบเทียบค่าแอบซอร์บแนนซ์ของสารเมทิลีนบลูบนฟิล์มเมื่อฉายแสงญี่วีเวลาที่เวลาต่าง ๆ กัน การทดสอบสมบัติ โฟโตคตะไลติกของฟิล์มจะพิจารณาเปรียบเทียบค่าแอบซอร์บแนนซ์ของสารเมทิลีนบลูบนกระจาดเคลือบฟิล์มไทยนานียมไดออกไซด์ โดยมีกระจกเปล่าไม่เคลือบฟิล์มเป็นตัวเปรียบเทียบ พบร่วมกับฟิล์มไทยนานียมไดออกไซด์ที่มีความหนาต่างกันทุกค่า สามารถเกิดสมบัติ โฟโตคตะไลติกไดเมื่อสัมผัสแสงญี่วีและเมื่อฉายแสงญี่วีเป็นเวลา 6 ชั่วโมง พบค่าแอบซอร์บแนนซ์ของสารเมทิลีนบลูลดลงเป็นดังนี้ฟิล์มที่ความหนา 51 nm ค่าแอบซอร์บแนนซ์ของสารเมทิลีนบลูลดลง -0.007 ฟิล์มที่มีความหนา 73 nm ค่าแอบซอร์บแนนซ์ลดลง -0.007 ฟิล์มที่มีความหนา 133 nm ค่าแอบซอร์บแนนซ์ลดลง -0.017 ฟิล์มที่มีความหนา 184 nm ค่าแอบซอร์บแนนซ์ลดลง -0.02 และฟิล์มที่มีความหนา 220 nm ค่าแอบซอร์บแนนซ์ของสารเมทิลีนบลูลดลง -0.027 จากภาพที่ 4-16 แสดงค่าการส่งผ่านแสงที่เพิ่มขึ้นเมื่อการฉายแสงญี่วี 6 ชั่วโมง หลังการทดสอบสมบัติ โฟโตคตะไลติกของฟิล์มบางไทยนานียมไดออกไซด์ เป็นการเปรียบเทียบผลต่างค่าการส่งผ่านแสงก่อนฉายแสงญี่วี ( $\%T_0$ ) และการส่งผ่านแสงหลังฉายแสงญี่วี ( $\%T_6$ ) เป็นเวลา 6 ชั่วโมง  $\Delta T\% = \%T_6 - \%T_0$  เมื่อเกิดการย่อยสลายสารเมทิลีนบลูในกระบวนการ โฟโตคตะไลติกแล้ว สารเมทิลีนบลูที่คงอยู่บนผิวของฟิล์มไทยนานียมไดออกไซด์จะมีสีทางลงและส่งผ่านแสงได้ดีขึ้น รายละเอียดแสดงในตาราง ก-4



ภาพที่ 4-15 ค่าแอนซอร์แบนซ์ของสารเมทิลีนบลูจากการทดสอบสมบัติโฟโตคอะไดิก  
ของฟิล์มที่มีความหนาต่างกัน

- (a) ความหนาเท่ากับ 51 nm
- (b) ความหนาเท่ากับ 73 nm
- (c) ความหนาเท่ากับ 133 nm
- (d) ความหนาเท่ากับ 184 nm
- (e) ความหนาเท่ากับ 220 nm



ภาพที่ 4-16 ค่าการส่งผ่านแสงของฟิล์มที่ข้อมเมทิลีนบัลู เมื่อสัมผัสแสงยูวีเป็นเวลา 6 ชั่วโมง  
หลังการทดสอบสมบัติโฟโตกะตะไอลiticของฟิล์มไทยทานียมไคลอออกไซด์  
ที่มีความหนาต่างกัน

- (a) ความหนาเท่ากับ 51 nm
- (b) ความหนาเท่ากับ 73 nm
- (c) ความหนาเท่ากับ 133 nm
- (d) ความหนาเท่ากับ 184 nm
- (e) ความหนาเท่ากับ 220 nm